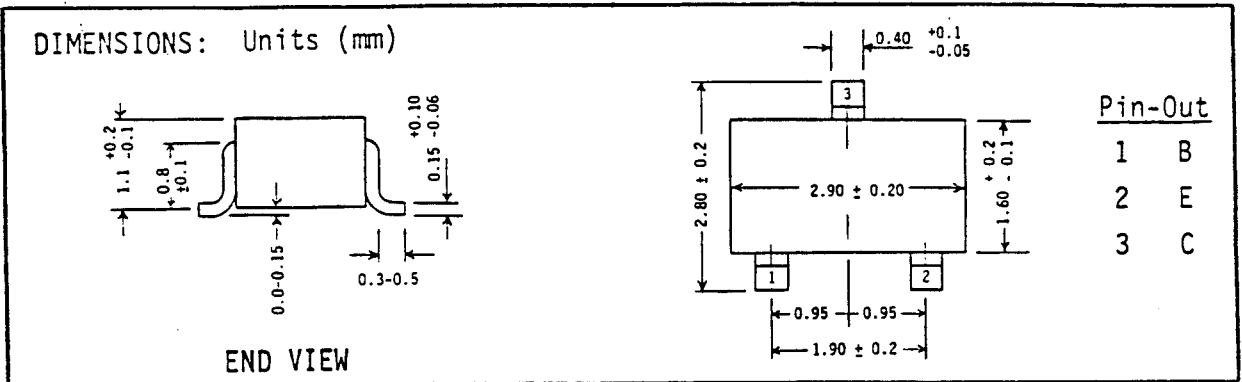


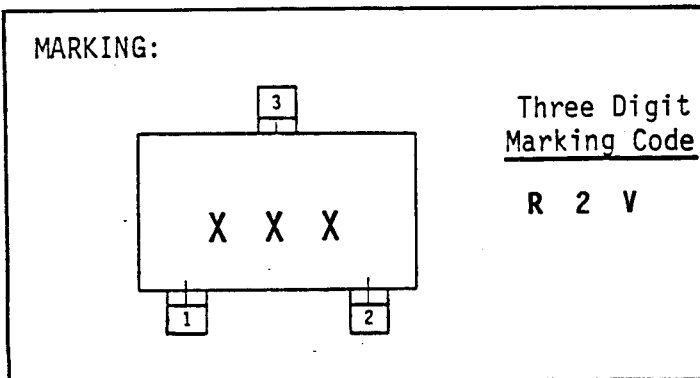
CUSTOMER	NO.	MMST-A64
	PAGE	1 of 2
	DATE	January 14, 1987
SUBJECT		
SOT-23 TRANSISTOR, PNP, SILICON		

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS: (Ta = 25°C)

Collector-Base Voltage	V _{CB0}	30 V
Collector-Emitter Voltage	V _{CE0}	30 V
Emitter-Base Voltage	V _{EB0}	10 V
Collector Current	I _C	500 mA
Power Dissipation-Free Air	P _D	200 mW
Power Dissipation-Ceramic Substrate	P _D	350 mW
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-55 to 150 °C
Solder Temperature (10 seconds)		260 °C



THE JAPANESE STYLE SC-59 PACKAGE



PACKAGING:

_____	BULK, 500 per BAG
_____	MAGAZINES OF 50 EACH
_____	8mm T&R, T-146 3K/REEL
_____	8mm T&R, T-147 3K/REEL
_____	8mm T&R, T-24610K/REEL
_____	8mm T&R, T-24710K/REEL

REMARKS: PROCESS: B-25 Thermal Resistance R_{θJA} 625 °C/Watt
FREE AIR, T_A = 25°C

ROHM ELECTRONICS
3034 Owen Drive, Antioch, TN 37013
TEL: (615) 641-2020 FAX: (615) 641-2022

APPROVAL

CHECK

DESIGN

10/12/87

MASTER

CUSTOMER	NO. MMST-A64
SUBJECT TRANSISTOR, PNP ,SILICON SOT-23	PAGE 2 of 2
	DATE January 14, 1987

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (Ta = 25°C Unless Otherwise Specified)

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
BVCES	IC = 100 uA	30			V
ICBO	VCB = 30 V		1.0	100	nA
IEBO	VEB = 10 V		1.0	100	nA
hFE	IC = 10 mA, VCE = 5 V	10,000			
hFE	IC = 100 mA, VCE = 5 V	20,000			
VCE(SAT)	IC = 100 mA, IB = 100 uA			1.5	V
VBE(ON)	IC = 100 mA, VCE = 5 V			2.0	V
fT	IC = 100 mA, VCE = 5 V, f = 100MHz	125			MHz
Cob	VCB = 10 V, IE = 0, f = 100KHz		4.0		pF
hfe	IC = 10 mA, VCE = 5 V, f = 1.0KHz		35,000		
NF	IC = 1.0 mA, VCE = 5 V, Rs = 100KΩ f = 1.0 KHz		2.0		dB

R-Ohm Corporation P.O. Box 19515 Irvine, California 92713	APPROVAL <i>[Signature]</i> 10/12/89	CHECK ✓	DESIGN
---	---	------------	--------

MASTER

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9